

# Silicon Diode

## **BA177**

50V / 100mA

# DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1972/73

**BA 177**

Nicht für Neuentwicklungen

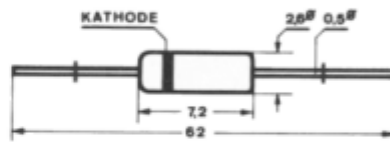
**Diffundierte-Silizium-Diode als Bereichsschalter für VHF.**

Diffused silicon diode for use as VHF switch.

**Abmessungen · Dimensions**

Maße in mm

M 2:1



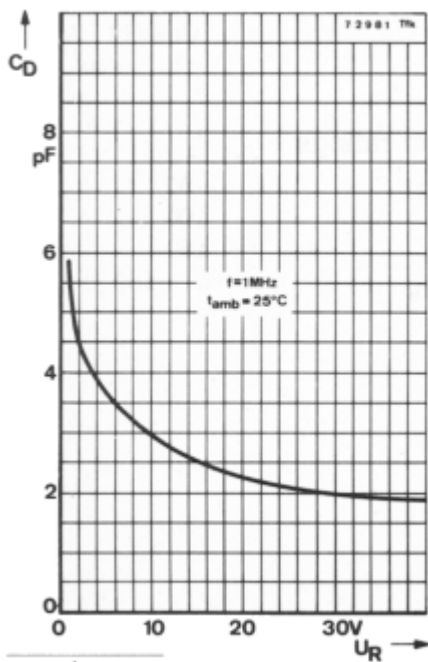
Normgehäuse  
JEDEC DO 7  
Gewicht · Weight  
max. 0,2 g

**Absolute Grenzdaten · Absolute maximum ratings**

Sperrspannung	$U_R$	50	V
Durchlaßstrom	$I_F$	100	mA
Sperrschichttemperatur	$t_j$	150	°C
Lagerungstemperatur	$t_{stg}$	-65...+150	°C

# BA 177

	Min.	Typ.	Max.
<b>Wärmewiderstand · Thermal resistance</b>			
Sperrschicht-Umgebung			500 °C/W
	$R_{thJA}$		
<b>Kenngößen · Characteristics</b>			
Umgebungstemperatur $t_{amb} = 25^{\circ}C$			
Durchlaßspannung			1 V
$I_F = 60\text{ mA}$	$U_F^{1)}$		
Sperrstrom			100 nA
$U_R = 40\text{ V}$	$I_R$		
Diodenkapazität			
$U_R = 2\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_D$		4,5 pF
$U_R = 30\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_D$		2 pF
Differentieller Durchlaßwiderstand			
$I_F = 50\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$	$r_f$		0,55 $\Omega$
$I_F = 100\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$	$r_f$		0,45 $\Omega$



1)  $t_p = 0,01, t_r = 0,3\text{ ms}$

